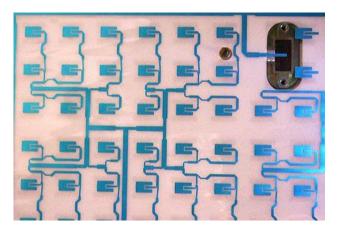
# PHẦN 6: ANTEN MẠCH DẢI

Trần Thị Thúy Quỳnh Trường Đại học Công nghệ - Đại học Quốc gia Hà Nội

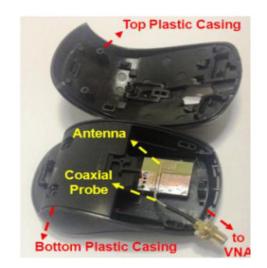




# Anten mạch dải



Anten thu truyền hình vệ tinh



Chuột không dây

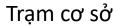




Điện thoại di động



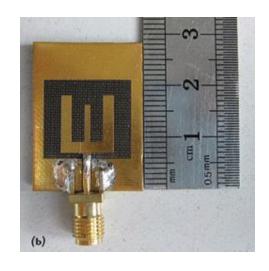


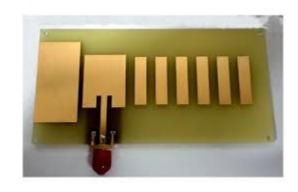


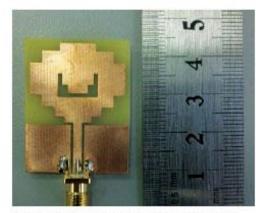




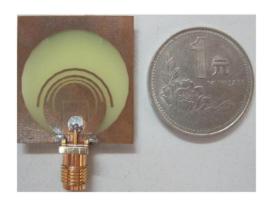
# Anten mạch dải



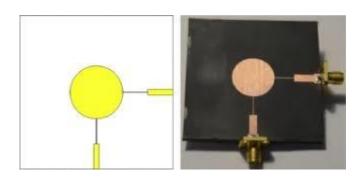




This photograph shows the proposed CPW UWB antenna as fabricated on FR-4 circuit laminate material.





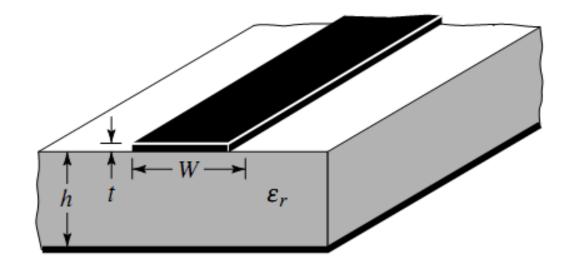






# Cấu trúc mạch dải

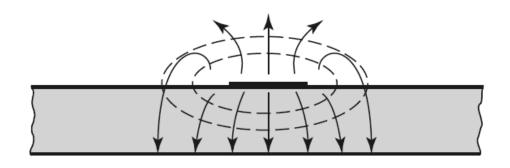
- Lớp đồng dẫn
- Lớp điện môi
- Lớp đất

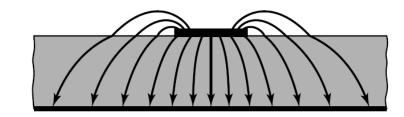




# Cấu trúc mạch dải

- Đường sức điện trường có phần lớn nằm trong tấm điện môi và một phần nằm trong không khí nên sóng truyền không đơn thuần là sóng TEM mà là quasi – TEM, tương đương hằng số điện môi hiệu dụng  $\epsilon_{\rm e}$ .



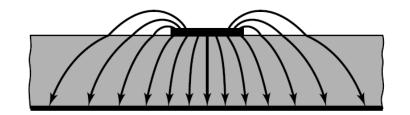


—— E



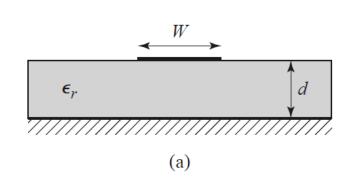
- Hằng số điện môi hiệu dụng

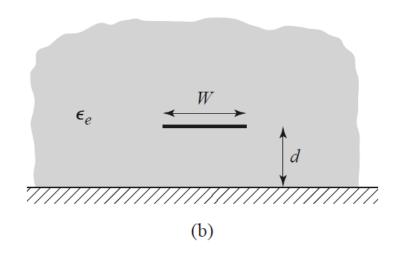
$$\epsilon_e = \frac{\epsilon_r + 1}{2} + \frac{\epsilon_r - 1}{2} \frac{1}{\sqrt{1 + 12d/W}}$$



- Vận tốc truyền sóng

$$v_p = \frac{c}{\sqrt{\epsilon_e}},$$
$$\beta = k_0 \sqrt{\epsilon_e},$$







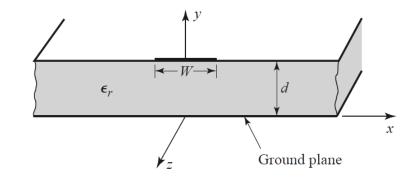


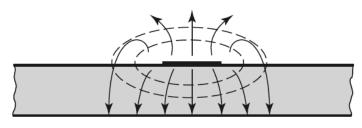
#### - Trở kháng đặc tính

$$Z_{0} = \begin{cases} \frac{60}{\sqrt{\epsilon_{e}}} \ln\left(\frac{8d}{W} + \frac{W}{4d}\right) & \text{for } W/d \leq 1\\ \frac{120\pi}{\sqrt{\epsilon_{e}} \left[W/d + 1.393 + 0.667 \ln\left(W/d + 1.444\right)\right]} & \text{for } W/d \geq 1. \end{cases}$$

$$\frac{W}{d} = \begin{cases}
\frac{8e^{A}}{e^{2A} - 2} & \text{for } W/d < 2 \\
\frac{2}{\pi} \left[ B - 1 - \ln(2B - 1) + \frac{\epsilon_{r} - 1}{2\epsilon_{r}} \left\{ \ln(B - 1) + 0.39 - \frac{0.61}{\epsilon_{r}} \right\} \right] & \text{for } W/d > 2, \\
---- H
\end{cases}$$

$$A = \frac{Z_0}{60} \sqrt{\frac{\epsilon_r + 1}{2}} + \frac{\epsilon_r - 1}{\epsilon_r + 1} \left( 0.23 + \frac{0.11}{\epsilon_r} \right)$$
$$B = \frac{377\pi}{2Z_0 \sqrt{\epsilon_r}}.$$









- Hãng sản suất mạch dải



http://www.taconic-add.com

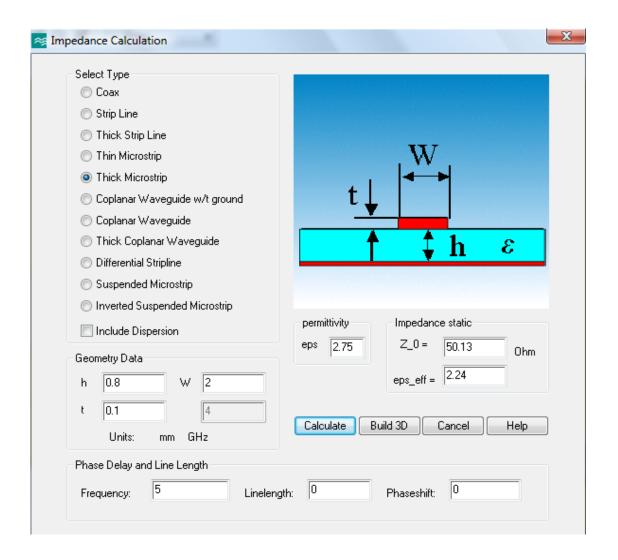


http://www.rogerscorp.com





- Phần mềm tính







### Cấu trúc anten mạch dải

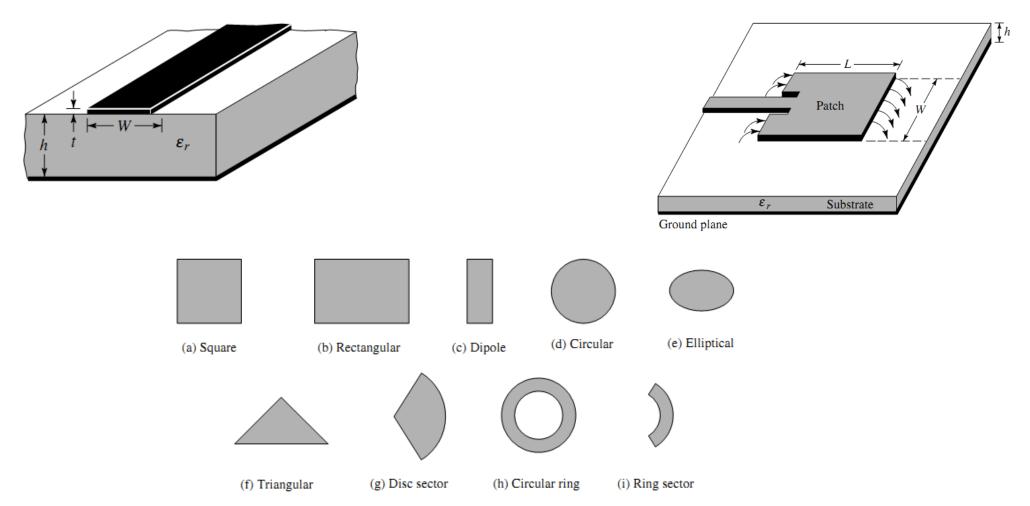
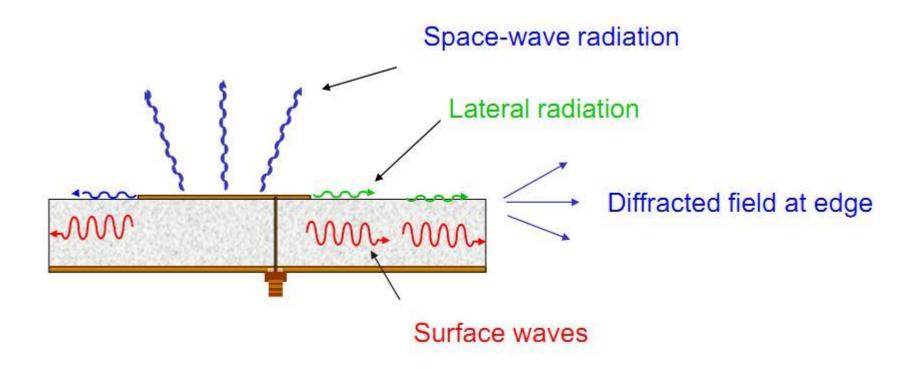


Figure 14.2 Representative shapes of microstrip patch elements.











#### Ưu điểm

- Trọng lượng nhẹ, thể tích nhỏ
- Giá thành chế tạo thấp, có thể sản xuất số lượng lớn
- Có thể tạo cả anten phân cực tuyến tính và phân cực tròn
- Cấu trúc phẳng, mỏng nên dễ uốn theo các bề mặt (phẳng, nón, trụ,...)
- Dễ tích hợp trong mạch tích hợp siêu cao tần (MICs Microwave Integrated Circuits)
- Có thể hoạt động tại nhiều băng tần
- Cấu trúc cơ khí chắc chắn





### Nhược điểm

- Băng hẹp
- Hiệu suất thấp
- Tăng ích thấp
- Khả năng chịu công suất thấp
- Kích thích sóng bề mặt (surface wave)
- Bức xạ ngoại lai từ các đầu nối và tiếp giáp
- Bức xạ theo hướng dọc trục kèm



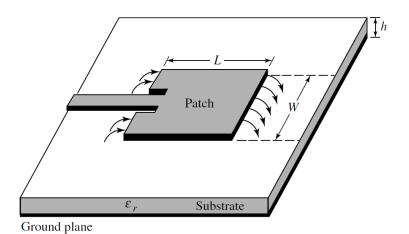


### Nhược điểm

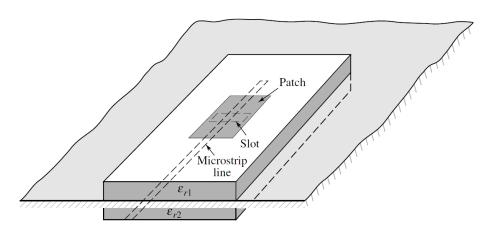
- Độ rộng băng và tăng ích của anten có thể được cải thiện bằng cách tăng bề dày của lớp điện môi. Tuy nhiên, việc này cũng tăng kích thích sóng bề mặt gây tổn hao công suất và các bức xạ không mong muốn (tán xạ tại các cạnh của tấm điện môi).
- **Tấm đất** nên được mở rộng khoảng 2 3 lần bề dày của tấm điện môi. Kích thước **quá nhỏ sẽ làm giảm tỷ số F/B**. **Kích thước lớn có thể tăng độ tăng ích** (do giảm bức xạ cạnh) **nhưng không tăng tuyến tính** (tăng kích thước tấm đất "đã lớn", độ tăng ích tăng rất ít).



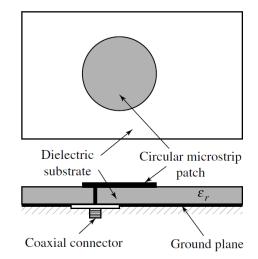
# Các hình thức tiếp điện



(a) Microstrip line feed



(c) Aperture-coupled feed



Patch  $\frac{\mathsf{Patch}}{\mathsf{Microstrip}}$   $\frac{\varepsilon_{r1}}{\varepsilon_{r2}}$ 

(d) Proximity-coupled feed



# Các hình thức tiếp điện

characteristics	Microstrip line feed	Coaxial feed	Aperture coupled feed	Proximity coupled feed
Spurious feed radiation	More	More	Less	Minimum
Reliability	Better	Poor due to soldering	Good	Good
Ease of fabrication	Easy	Soldering and Drilling needed	Alignment Required	Alignment Required
Impedance matching	Easy	Easy	Easy	Easy
Bandwidth	2-5%	2-5%	21%	13%



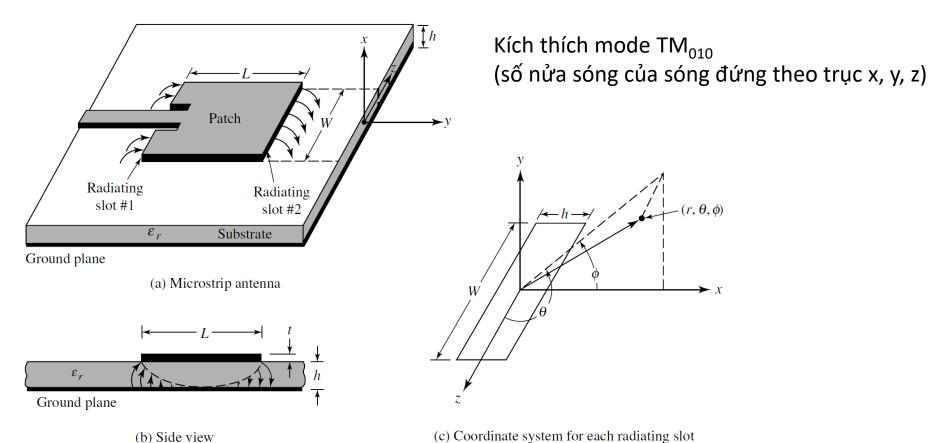


#### Anten mạch dải chữ nhật

- Phân tích theo mô hình đường truyền (đơn giản, dễ hiểu, độ chính xác thấp, khó mô tả trường hợp ghép)
- Phân tích theo mô hình hốc cộng hưởng (chính xác nhưng độ phức tạp lớn)
- Phân tích toàn sóng (rất chính xác nhưng phức tạp do cần giải hệ phương trình tích phân)



- Anten được coi tương đương hai khe bức xạ hẹp có kích thước mỗi khe  $W \times h$ , đặt cách nhau một khoảng L

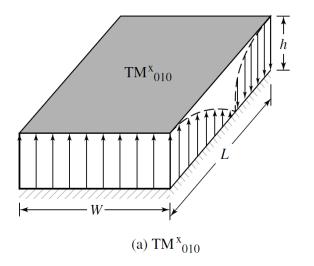


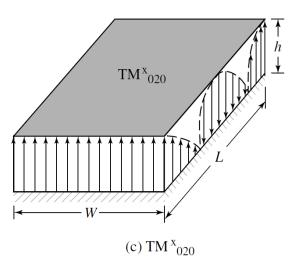


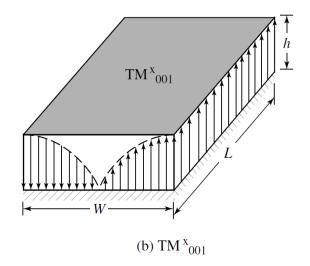


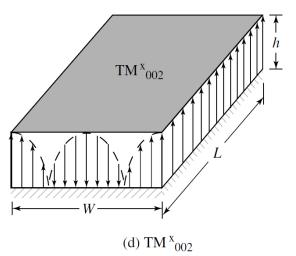
- Một số mode hoạt động của anten mạch dải chữ nhật (Phân bố điện trường)

Kích thích mode TM<sub>mnp</sub> (số nửa sóng của sóng đứng theo trục x, y, z)









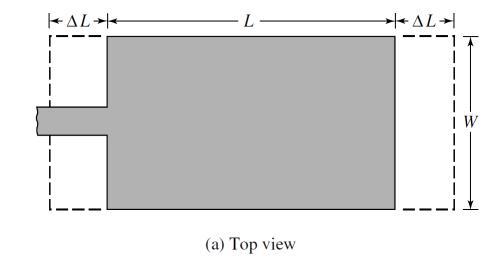


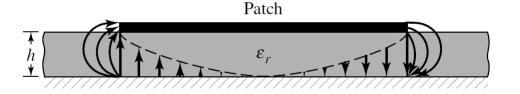


- Do hiệu ứng fringing, chiều dài điện lớn hơn chiều dài vật lý

$$\frac{\Delta L}{h} = 0.412 \frac{(\epsilon_{\text{reff}} + 0.3) \left(\frac{W}{h} + 0.264\right)}{(\epsilon_{\text{reff}} - 0.258) \left(\frac{W}{h} + 0.8\right)}$$

$$L_{\rm eff} = L + 2\Delta L$$





(b) Side view





- Kích thích mode  $TM_{010}$  trong trường hợp có và không có fringing:

$$(f_r)_{010} = \frac{1}{2L\sqrt{\epsilon_r}\sqrt{\mu_0\epsilon_0}} = \frac{\upsilon_0}{2L\sqrt{\epsilon_r}}$$

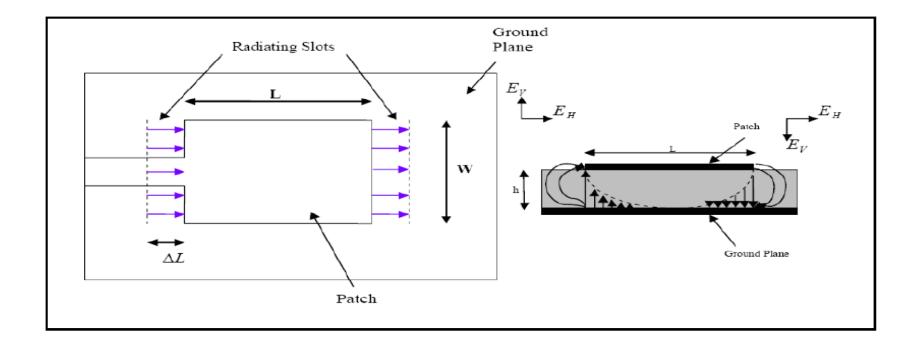
$$(f_{rc})_{010} = \frac{1}{2L_{\text{eff}}\sqrt{\epsilon_{\text{reff}}}\sqrt{\mu_0\epsilon_0}} = \frac{1}{2(L+2\Delta L)\sqrt{\epsilon_{\text{reff}}}\sqrt{\mu_0\epsilon_0}}$$

$$= q\frac{1}{2L\sqrt{\epsilon_r}\sqrt{\mu_0\epsilon_0}} = q\frac{\upsilon_0}{2L\sqrt{\epsilon_r}}$$

- Hệ số fringer:  $q=\frac{(f_{rc})_{010}}{(f_r)_{010}}$
- Lớp điện môi càng dầy, hiện tượng fringing tăng, chiều dài điện tăng, tần số cộng hưởng thấp hơn





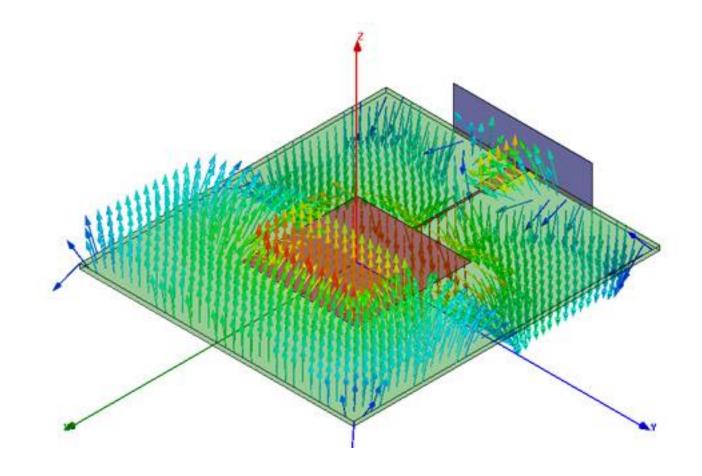


Trường tại hai cạnh được phân tích thành các thành phần dọc ( $E_v$ ) và ngang ( $E_H$ ). Khi đó, tại hướng vuông góc, các thành phần dọc ngược pha bị triệt tiêu, anten được coi như hai khe bức xạ có điện trường ngang cùng pha.



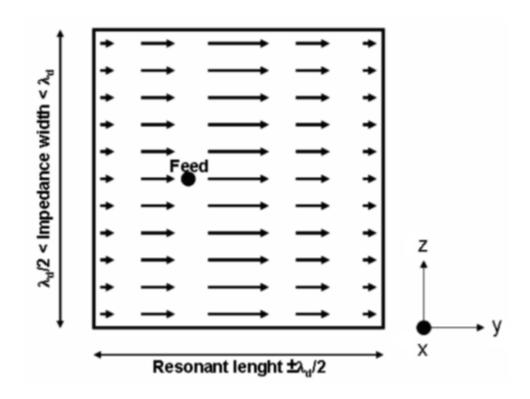


Vector điện trường E

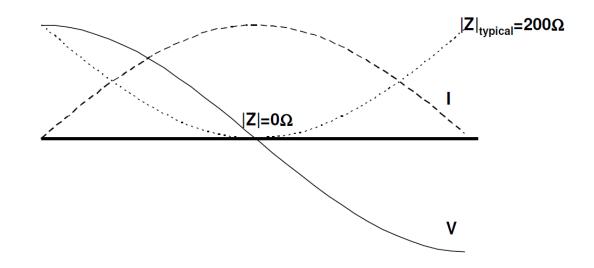




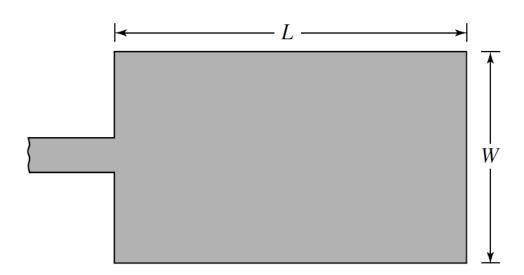




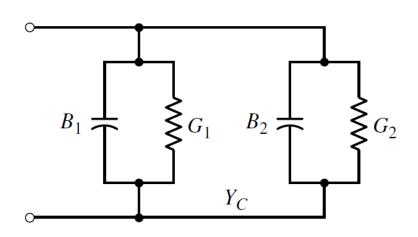
Kích thích mode  $TM_{010}$  (số nửa sóng của sóng đứng theo trục x, y, z), thành phần  $H_{\rm y}$ 











(a) Rectangular patch

(b) Transmission model equivalent

$$Y_2 = Y_1, \quad G_2 = G_1, \quad B_2 = B_1$$

$$G_1 = \frac{W}{120\lambda_0} \left[ 1 - \frac{1}{24} (k_0 h)^2 \right] \qquad \frac{h}{\lambda_0} < \frac{1}{10}$$

$$B_1 = \frac{W}{120\lambda_0} [1 - 0.636 \ln(k_0 h)] \qquad \frac{h}{\lambda_0} < \frac{1}{10}$$





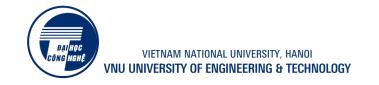
Với khoảng cách giữa hai khe là  $\lambda_d/2$ , Tại lối vào anten,  $Y_2$  trở thành:

$$\tilde{Y}_2 = \tilde{G}_2 + j\tilde{B}_2 = G_1 - jB_1$$

Do đó, dẫn nạp vào (không có ghép tương hỗ):

$$Y_{in} = Y_1 + \tilde{Y}_2 = 2G_1$$

$$Z_{in} = \frac{1}{Y_{in}} = R_{in} = \frac{1}{2G_1}$$





Do đó, dẫn nạp vào (không có ghép tương hỗ):

$$R_{in} = \frac{1}{2(G_1 \pm G_{12})}$$
  $G_{12} = \frac{1}{|V_0|^2} \text{Re} \iint_S \mathbf{E}_1 \times \mathbf{H}_2^* \cdot d\mathbf{s}$ 

$$G_{12} = \frac{1}{120\pi^2} \int_0^{\pi} \left[ \frac{\sin\left(\frac{k_0 W}{2} \cos \theta\right)}{\cos \theta} \right]^2 J_0(k_0 L \sin \theta) \sin^3 \theta \, d\theta$$

J<sub>0</sub> là hàm Bessel loại 1, bậc 0.





$$R_{in}(y = y_0) = \frac{1}{2(G_1 \pm G_{12})} \left[ \cos^2 \left( \frac{\pi}{L} y_0 \right) + \frac{G_1^2 + B_1^2}{Y_c^2} \sin^2 \left( \frac{\pi}{L} y_0 \right) - \frac{B_1}{Y_c} \sin \left( \frac{2\pi}{L} y_0 \right) \right]$$

Với các mạch dải thông thường thì  $G_1/Y_0 \ll 1$  và  $B_1/Y_0 \ll 1$ , ta có:

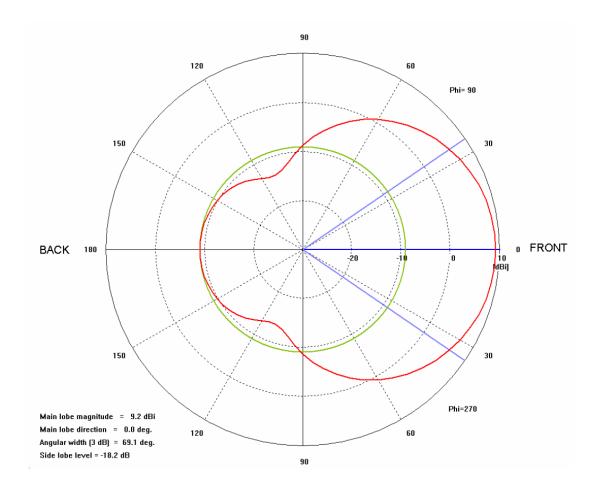
$$R_{in}(y = y_0) = \frac{1}{2(G_1 \pm G_{12})} \cos^2\left(\frac{\pi}{L}y_0\right)$$
$$= R_{in}(y = 0) \cos^2\left(\frac{\pi}{L}y_0\right)$$





### Đặc trưng bức xạ

- Hiệu suất trên 90%
- Độ định hướng:
- Mỗi khe có độ định hướng khoảng 2-3dBi,
- Hai khe có độ định hướng tăng thêm 3dB,
- Độ định hướng cực đại 8 9dBi







### Đặc trưng bức xạ

ern: talk E- and H-Plane Radiation Patterns Patch Antenna

